miomation



L 133 C

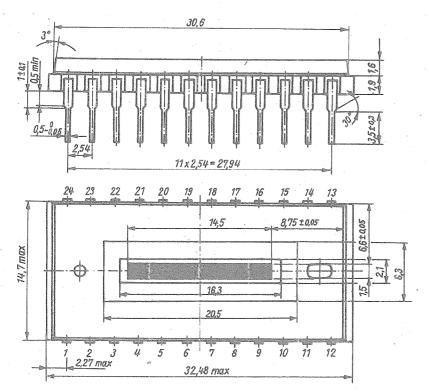
1/89 (14)

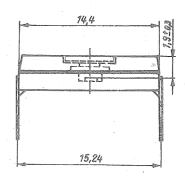
Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

Dié L 133 C ist eine monolithische selbstabtastende, lichtempfindliche Zeile mit 1024 Sensorelementen.

Sie ist für optische Erkennungssysteme bestimmt. Neben den Sensorelementen beinhal-

tet das Bauelement ein Übertragungsgate, Schieberegister, Ladungsdetektoren und Ausgangsverstärker, Takttreiberschaltung, Dunkel- und Hellreferenzschaltung.





Kenngrößen ¹⁾ bei ϑ_{a} = 25 °C; f _{DAT} =	5 MHz; t _{int} =	1 ms min.	typ.	max.	\$ 1.00 1.00 1.00	
Sättigungsausgangsspannung	Usat	1	2	ed:	A	
Dunkelsignal	DS					
DS-Gleichspannungskomponente	DSDC					
Niederfrequenzkomponente	DSNF	490	420	5	mV/ms	
Hellsignaldifferenz ²)	PRNU	· ·		240	wV	
Dynamikbereich	DR					* .
bezogen auf Spitze/Spitze-Rauschen		500	em .	-		
bezogen auf Effektiv-Rauschen		2500	100	4949		
Dunkelsignaldifferenz	DSNU	en d	enco .	20	mV/ms	
Empfindlichkeit ³)	S	1,8	3		V/µJ cm ⁻²	
Differenz zwischen A und B		Tra.			(bei klarem	Fenster)
im Videosignal ⁴⁾	.M .	600	e v	160	mV	
Gleichspannungsdifferenz	MDC	edi 		. 2	Λ	

¹⁾ Normlichtart A mit Filter BG 38 (2 mm dick)

Statische Betriebswerte		min.	max.		Informationswerte bei & = 2	25 °C		
ersorgungsspannung der Ausgangsverstärker	u _{DD}	13,5	14,5	V	Wirkungsgrad der Ladungsübertragung	TE C	,99999;	Ohm
Versorgungsstrom der					Ausgangsimpedanz Z	. 7	50	
Ausgangsverstärker	\mathbb{I}_{DD}	690	25	mA	Ausgangsgleichspannungs-			
Versorgungsspannung					pegel U	0	8	Λ
der Takttreiber	UCD	13,5	14,5	V	mex. Bildpunkt-			
Versorgungsstrom					ausgabefrequenz ⁶) f ₁	DAT max	50	MHz
der Takttreiber	I^{CD}	mig	15	mA				
Spannung für die		51			5) Eingangskapazitäten: C _X ?	≈ 150 pF	³ •	
Schieberegister	$\mathbf{u}_{\mathbf{T}}$	5,5	6,5	A	C _T ≈ 350 pF			
Spannung für die					6) f _{DAT} = 2 · f _{Transport}			
Eingangsdiode	$\mathtt{u}_{\mathtt{Ei}}$	10,5	bis 12		Grenzwerte bei & = -25 bis	70 °c		
Substrat (Masse)	USS	0		V	ST CTUTY OF ST			
Impulsbetriebswerte					Spannungen an den	n n	in. max.	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR
Low-Wert vom Übertragungs	}				Anschlüssen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16			
und Transporttakt5)	GXL	0	0,5	V	17, 18, 21, 22, 23, 24	C	3 18	V
Bigh-Wert vom Übertra-	UGTL		, -		Spannung am Anschluß 13		. 0	٧
gungs- und Transporttakt	U _{GXH}				Anschlüsse	R.		
S street to the	UGTH	11	13	V		icht bes	chalten	
Phasenlage der Takt-					Verlustleistung			
spannungen siehe Seite 5					Takttroiber P	n	- 300	mW
				il de la companya de		2		

²⁾ gemessen bei $U_{VIDEO} = 800 \text{ mV}$

⁴⁾ Diese Differenz kann durch externe Videosignslverstärkungsänderung ausgeglichen werden.

Verstärker P _A - 35	O mW
Bildpunktausgabe-	
frequenz f_{DAT} 12 -	MHz
Betriebstemperatur-	Contract of
bereich & -25 7	o °c
Lagerungstemperatur-	
bereich über eine	
Zeit von 1 Monat $\vartheta_{ m stg}$ -50 1	00 °C

Anwendungshinweise

Das Bauelement I 133 C ist mit internen "Sample und Hold"-Stufen ausgerüstet. Durch kapazitätsarmes Überbrücken der Anschlüsse 2 und 3 sowie 21 und 22 direkt an der Fassung ist eine Bildklemmung möglich. Die Signalausgänge liefern dann bei dieser Betriebsart bildpunktgeklemmte Videosignale. Ohne diese Anschlußüberbrückung werden Videosignale ohne Bildpunktklemmung ausgegeben. Bei dieser Betriebsart ist an die Anschlüsse 2 und 22 eine Gleichspannung von 10 bis 14 V zu legen.

Steckfassung: 24 pol. IS-Fassung, Form 112/24 nach TGL 36 665.

Maßangaben zum Strahlungsempfangsteil und Chip

Abmessungen der Sensoren 13 µm x 13 µm (1024 = 13,3123 mm)

Mittenabstand der Sensoren 13 µm

Abstand von der Oberfläche der Glasscheibe bis zur

Chipoberfläche

1,9 ±0,3

Chipabmaße

14,5 x 1,5

Abstand des Chips von der oberen Gehäusekante

6,6 ±0,05

Abstand des Chips von der

0,0 0,02

rechten Gehäusekante

8,75 ±0,05

Gehäuseausführung: 24poliges DIL-Gehäuse

Unterseite: Keramik

Oberseite: Plast mit Fenster

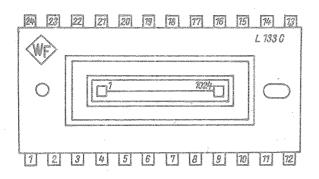
Oberfläche der Anschlüsse:

vergoldet

Masse: 3,4 g

Bauform: 21.2.3.2.84 nach TGL 26 713

Standard: TGL 55 108



PIN	Belegung	Kurzbe- zeichnung
1	Videosusgang A	VIDEO _{out} A
2	Gate des Sample und Hold Transistors A	U _{SHA}
3	Sample und Hold Takt- ausgang A	SHout
4	Versorgungsspannung für Takttreiber	UCD
5	nicht anschließen	NC
6	nicht anschließen	NC
7	nicht anschließen	NC
8	Versorgungsspannung für Takttreiber	$\mathbf{u}_{\mathtt{CD}}$
9	Signalausgang "Ende der Abtastung"	EOSout
10	nicht anschließen	NC
11	Gleichspannungsgate Schieberegister A	$\mathbf{U}_{\mathbf{T}}$
12	Eingangsdiode zur Erzeugung des Weiß-Referenzpegels und Amplitude des Signals "EOS"	UEi
13	Masse (Substrat)	Uss
14	intern nicht beschaltet	NC
15	Übertragungsgate	\mathbf{U}_{GX}
16	Taktgate der Schieberegister	UGT
17	Gleichspannungsgate Schieberegister B	$\mathtt{U}_{\mathbf{T}}$
18	Versorgungsspannung	$\mathtt{u}_{\mathrm{DD}}^-$
19	nicht anschließen	NC
20	nicht anschließen	NC
21	Sample und Hold Taktausgang B	SH _{out} B
22 \	Gate des Sample und Hold Transistors B	USHB
23	Videoausgang B	VIDEO out B
24	Versorgungsspannung	U _{DD}

Funktionsbeschreibung

Lichtempfindlicher Teil

Die in einer Reihe angeordneten 1024 lichtempfindlichen Elemente sind durch geeignet dotierte Gebiete voneinander getrennt. Das einfallende Licht dringt nach Passieren einer transparenten SiO₂-Schicht in das Silizium ein.

Die absorbierten Photonen erzeugen Elektronen-Loch-Paare. Während die Löcher zum Substrat abfließen, werden die fotogenerierten Elektronen von den Sensorelementen gesammelt und den (gegen Licht abgeschirmten) Speicherzellen zugeführt.

Die akkumulierte Ladung hängt linear von der Beleuchtungsstärke und der Integrationszeit ab.

Ubertragungsgate

Die Speicherzellen sind von den beiden BCCD-Schieberegistern durch ein Gebiet getrennt, das vom Übertragungsgate gesteuert wird.
Bei H-Pegel am Übertragungsgate kann die fotogenerierte Ladung aus den Speicherzellen in die unter den Speichergate's der Schieberegister befindlichen Halbleitergebiete fließen.

Der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender H-Impulse am Übertragungsgate bestimmt die Bestrahlungszeit der lichtempfindlichen Sensorelemente.

Schieberegister

Es sind insgesamt vier BCCD-Analogschieberegister angeordnet. Dazu zählen die Transportregister A und B, das EOS-Register und ein Zusatzregister. Von den Transportregistern

wird eine aus den Speicherzellen eingespeiste Signalladung zu den Ladungsdetektoren transportiert. Die Transportregister sind so angeordnet, daß die Ladungen der mit ungerader Zahl bezifferten Sensorelemente (1,3,...1023) in das Register A; die Ladungen der mit gerader Zahl bezifferten Sensorelemente (2,4, ... 1024) in das Register B eingelesen werden. In den Anfang des EOS-Registers wird mit jede H-Impuls am Übertragungsgate eine Ladung eingelesen, welche nach insgesamt 529 Schiebetakten in den EOS-Ladungsdetektor eingegeben wird. Das detektierte und verstärkte EOS-Signal zeigt das Ende des Auslesens der gesamten Zeile an. Das Zusatzregister dient der Verbesserung des Dunkelsignalverhaltens.

Ladungsdetektoren und Ausgangsverstärker

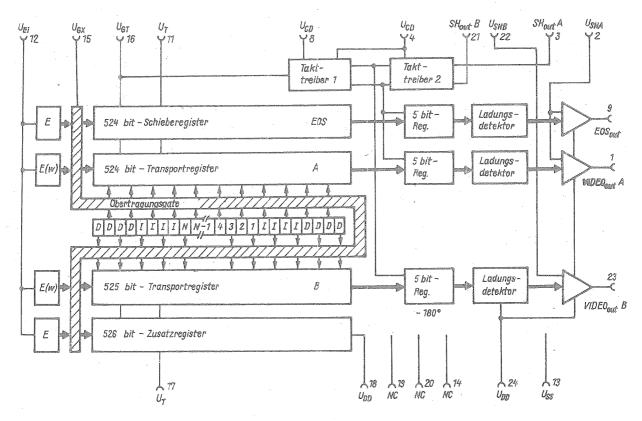
Die von den Registern A und B transportierten Signalladungen werden von zwei Ladungsdetektoren in zur Größe der Ladung proportionale Spannungssignale umgewandelt:

Nach jedem Ladungsdetektor sind Ausgangsverstärker angeordnet. Diese werden durch zwei MOS-Transistoren und einem dazwischenliegenden "Sample- und Hold"-Transistor gebildet.

An den Videoausgängen erscheinen die der Beleuchtungsstärke proportionalen Spannungssignale der mit ungerader oder gerader Zahl bezifferten Sensorelemente.

Nach dem Übernahmeimpuls \mathbf{U}_{GX} sind 10 Schieberegistertakte \mathbf{U}_{GT} erforderlich, damit die erste Bildpunktinformation am Ausgang zur Verfügung steht.

Ein dritter Ladungsdetektor und ein Ausgangsverstärker mit "Sample- und Hold"-Stufen ist an das EOS-Register angeschlossen und erzeugt am Ende des Auslesevorganges ein Spannungssignal.



⁼ Eingangsdiode = Tsolationszell

= Isolationszellen = Dunkelsignalzellen

E(w) = Eingangsdiode für Weißsignaleingabe 1...N= 1024 Strahlungsemplangssensoren

Takttreiberschaltung

einzuschachteln

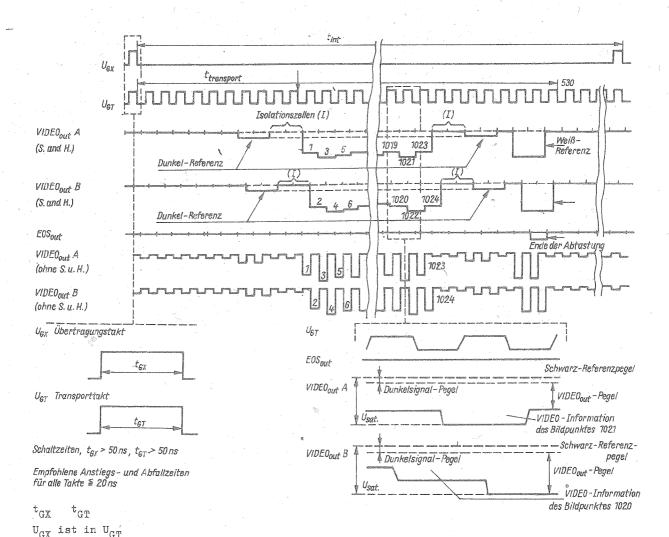
Diese Schaltung gestattet den Betrieb der L 133 C mit nur 2 externen Taktspannungen

- einem Rechteck-Transporttakt, welcher die Auslesegeschwindigkeit der Videodaten aus dem Sensor steuert und
- einem Übertragungstakt, welcher die Integrationszeit des Sensor steuert.

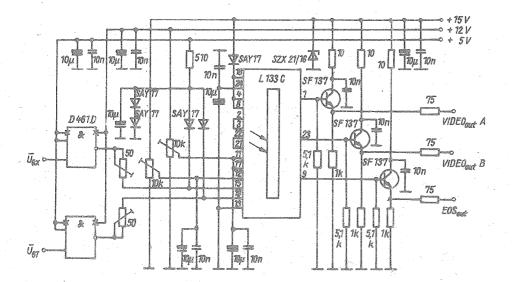
Dunkel- und Hellreferenzschaltung

Vier zusätzliche Sensorelemente an beiden Enden der Sensorzeile werden mit einer lichtundurchlässigen Metallschicht bedeckt. Sie erzeugen ein Dunkel-Referenzsignal (keine Belichtung), welches von beiden Enden der Zeile auf den Videoausgang übertragen wird (im Blockdiagramm, Seite 4, mit "D" bezeichnet).

Außerdem sind am Ende der Sensorzeile Referenzpegelgeneratoren für ein Hellreferenzsignal integriert (im Blockdiagramm, Seite 4, mit "E(w)" bezeichnet). Diese Referenzpegel sind Bezugssignale für die Ausgangssignalgewihnung sowie für weitere Signalverarbeitung.

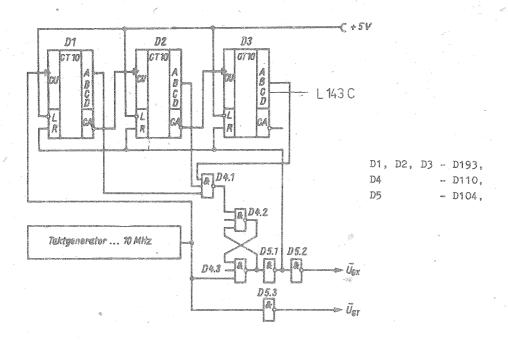


Impulsdiagramm der Taktimpulse und Ausgangssignale



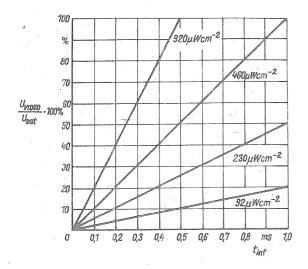
D461D, SF 137, SZX 21/16, SAY 17,

Beschaltungsvorschlag für die L 133 C (Sample und Holdbetrieb)

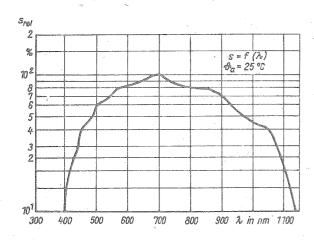


Schaltungsvorschlag: Taktimpulserzeugung L 133 C (Synchronbetrieb)

560 bis 990 nm.



typische Werte für L 133 C mit $U_{\rm SAT}$ = 1,50 V im angegebenen Spektralbereich gilt für die Bestrahlungsart der Umrechnungsfaktor 1 lx = 0,29 μ Wcm⁻² Bestrahlung mit Normlichtart A und Filter BG 38 (2 mm dick), gemessen im Bereich



Mittelwert aller Pixel der Sensorzeile

Änderungen vorbehalten!

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information!
Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

veb applikationszentrum elektronik berlin im veb kombinet mikroelektronik

Mainzer Straße 25

Berlin, 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055